DIALOG(R) File 347: JAP10

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04634281 \*\*Image available\*\*

PROCESS AND APPARATUS FOR PRODUCING ORGANIC OPTICAL THIN FILM

PUB. NO.:

06-306181 [JP 6306181 A]

PUBL I SHED:

November 01, 1994 (19941101)

INVENTOR(s): HIRAGA TAKASHI

MORIYA TETSUO

TANAKA NORIO

APPLICANT(s): AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL [000114] (A Japanese

Government or Municipal Agency), JP (Japan)

RES DEV CORP OF JAPAN [330319] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO LTD [000282] (A Japanese

Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

05-052102 [JP 9352102]

FILED:

March 12, 1993 (19930312)

INTL CLASS:

[5] C08J-005/00; G02B-001/04; G02F-001/35

JAPIO CLASS: 14.2 (ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds);

29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To obtain the film having a controlled fine structure at a lower temperature without causing the heat decomposition of optical material by spraying a solution or dispersion of an organic optical material into a high-vacuum vessel, depositing the material on a substrate, and heating the deposit.

CONSTITUTION: A vacuum vessel 3 is drawn through a vacuum pump 4 to a high vacuum of 1X10(sup -4)mmHg or below. A solution or dispersion of an organic optical material held in a liquid reservoir 18 is sprayed into the vessel 3 through an open/shut mechanism 2 and a control nozzle part 1 to deposit the material on a substrate 19. A substrate heater 20 is energized to heat the substrate 19, and the vapor of the solvent, etc., are trapped with a cold trap 6. After confirming that the volatile component has been completely removed from the deposit by means of a gate valve 11, an ionization apparatus 12 and a mass spectrograph 13, the deposit is optionally formed under pressure.

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-306181

(43)公開日 平成6年(1994)11月1日

| (51) Int. Cl | 5    | 識別記号 |         | FI |
|--------------|------|------|---------|----|
| C08J         | 5/00 |      | 7016-4F |    |
| G02B         | 1/04 |      | 8807-2K |    |
| G02F         | 1/35 | 504  | 9316-2K |    |

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全8頁)

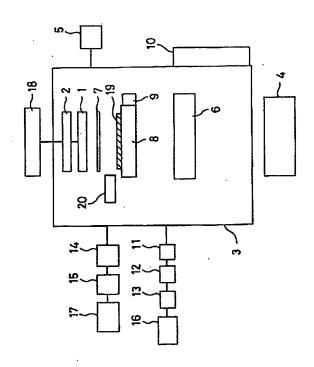
| (21)出願番号 | 特願平5-52102      | (71)出願人 000001144           |  |  |
|----------|-----------------|-----------------------------|--|--|
|          |                 | 工業技術院長                      |  |  |
| (22)出願日  | 平成5年(1993)3月12日 | 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号           |  |  |
|          |                 | (74)上記1名の復代理人 弁理士 西澤 利夫 (外1 |  |  |
|          |                 | 名)                          |  |  |
|          |                 | (71)出願人 390014535           |  |  |
|          |                 | 新技術事業団                      |  |  |
|          |                 | 埼玉県川口市本町4丁目1番8号             |  |  |
|          |                 | (71)出願人 000002820           |  |  |
|          |                 | 大日精化工業株式会社                  |  |  |
|          |                 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7番6号         |  |  |
|          |                 | (74)上記2名の代理人 弁理士 西澤 利夫      |  |  |
|          |                 | 最終頁に続く                      |  |  |

# (54) 【発明の名称】有機系光学薄膜の製造法とその装置

# (57)【要約】

【構成】 溶液または分散液状態の有機系光学材料を高 真空容器内に噴霧して基板上に堆積させ、加熱処理す る。また、必要に応じてさらに加圧処理する。

【効果】 より低温度において、光学材料の熱分解をもたらすことなく微細構造制御された高品質、高機能な有機系光学薄膜が形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 溶液または分散液状態の有機系光学材料 を髙真空容器内に噴霧して基板上に堆積させ、加熱処理 することを特徴とする有機系光学薄膜の製造法。

1

【請求項2】 請求項1の加熱処理の後に加圧成形する ことを特徴とする有機系光学薄膜の製造法。

【請求項3】 真空容器とこの真空容器内に溶液または 分散液状態の有機系光学材料を噴霧する手段と、真空容 器内において噴霧された有機系光学材料を堆積させる基 板とその加熱手段、および真空容器の排気手段とを備え 10 た装置であって、有機系光学材料の噴霧手段は、噴霧ノ ズル部とその開閉機構部とを有していることを特徴とす る有機系光学薄膜の製造装置。

【請求項4】 噴霧ノズル部とその開閉機構部は、ニー ドルバルブ構造を構成している請求項3の製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、有機系光学薄膜の製 造方法とその装置に関するものである。さらに詳しく は、この発明は、波長選択透過膜、反射膜、光非線形効 20 果膜、光電変換装置等の光技術、オプトエレクトロニク ス技術に有用な、高機能性の光学薄膜として、有機系光 学薄膜を髙品質、髙効率で製造することのできる新しい 製造方法とそのための装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術とその課題】従来より、各種の組成からな る光学薄膜が様々な応用分野において使用されており、 光の吸収あるいは干渉を利用した波長選択透過や反射機 能を利用したものが古くから知られている。そして特に の分野において、用途面では光の多重性を利用した情報 の多元並列高速処理のための応用や、現象面では光非線 形効果ないし光電気効果の応用のため、従来とは異なる 高い機能を有する光学薄膜の開発が盛んに進められてい

【0003】このような新しい高機能光学薄膜を形成す るための素材、その組成として注目されているものに有 機系光学材料がある。この有機系光学材料を用いた有機 系光学薄膜の製造方法についても各種の検討がこれまで れてもいる。

- (1) 溶液、分散液、または、展開液を用いる湿式法 塗布法、プレードコート法、ロールコート法、スピンコ ート法、ディッピング法、スプレー法などの塗工法、平 版、凸版、凹版、孔版、スクリーン、転写などの印刷 法、電着法、電解重合法、ミセル電解法(特開昭63-243298) などの電気化学的手法、水の上に形成さ せた単分子膜を移し取るラングミア・プロジェット法な ۳.
- (2) 原料モノマーの重合ないし重縮合反応を利用する 50 ることができる。

方法

モノマーが液体の場合、キャスティング法、リアクショ ン・インジェクション・モールド法、プラズマ重合法、 光重合法など。

- (3) 気体分子を用いる方法(加熱による気化法) 昇華転写法、蒸着法、真空蒸着法、イオンピーム法、ス パッタリング法、プラズマ重合法、光重合法など。
- (4) 溶融あるいは軟化を利用する方法 ホットプレス法(特開平4-99609)、射出成形 法、延伸法、溶融薄膜の単結晶化方法など。

【0004】しかしながら、これらの従来の製造方法の 場合には、対象とされる光学薄膜の組成、構造は比較的 単純なものに限られており、より高度な微細構造の制御 を可能とし、より高機能な有機系光学薄膜を製造するの には適していないのが実情であった。たとえば、従来の 方法においては、有機イオン結晶等の融点が存在しない 材料の場合には、加熱により分解してしまい、また融点 が存在しても気化温度において分解してしまうため、こ れらの現象を制御することや、この制御により高機能な 有機系光学薄膜を実現することは困難であった。

【0005】そこで、この発明は、以上の通りの従来技 術の欠点を解消し、光学材料の熱分解をもたらすことな く、より低温度において、しかもより高機能な有機系光 学薄膜を製造することができ、微細構造制御を可能とす るための新しい有機系光学薄膜の製造方法とそのための 装置を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題 を解決するために、溶液または分散液状態の有機系光学 近年は、レーザー光を利用したオプトエレクトロニクス 30 材料を高真空容器内に噴霧して基板上に堆積させ、加熱 処理することを特徴とする有機系光学薄膜の製造法を提 供する。また、この発明は、加熱処理後に、必要に応じ て加圧成形することを特徴とする製造法をも提供する。 【0007】さらに、この発明は、上記方法を実現する ための装置として、真空容器とこの真空容器内に溶液ま たは分散液状態の有機系光学材料を噴霧する手段と、真 空容器内において噴霧された有機系光学材料を堆積させ る基板とその加熱手段、および真空容器の排気手段とを 備えた装置であって、有機系光学材料の噴霧手段は、噴 にも進められており、たとえば以下のような方法が知ら 40 霧ノズル部とその開閉機構部とを有することを特徴とす る有機系光学薄膜の製造装置をも提供する。

> 【0008】さらに以下詳しく説明すると、まず、この 発明の方法において対象とする有機系光学薄膜の製造に は、それ自体が単独で、もしくは混合して、あるいは複 合化されて光学機能を実現する有機系光学材料が使用さ れる。この材料には、揮発性を有する溶媒に溶解し、あ るいは分散媒に分散できるものであれば任意の種類のも のが用いられる。その際には、無機粒子と混合した状 態、複数種のものを混合した材料等として適宜に使用す

10

【0009】具体的には有機高分子材料の溶液や無機微 粒子を有機高分子材料の溶液に分散した液、有機低分子 化合物および有機高分子材料を共通の溶剤に溶解した 液、有機化合物の微粒子を有機高分子材料の溶液に分散 した液、液晶および有機高分子材料を共通の溶剤に溶解 した液等を適宜に使用することができる。以下、さらに 具体的に例示してみる。

[有機高分子材料] 有機高分子化合物のうち、いわゆる 「光学的性質や機能」を有するものは、この発明の光学 薄膜の製造のための原材料として利用することができ る。また、有機高分子化合物は、光機能性の有機低分子 化合物の分子または凝集体、および無機化合物の微粒子 を分散し保持する材料、すなわち「マトリクス材料」と してもこの発明において利用することができる。

【0010】このような有機高分子材料の具体例として は、ポリスチレン、ポリ (α-メチルスチレン)、ポリ インデン、ポリ(4-メチル-1-ペンテン)、ポリビ ニルピリジン、ポリビニルホルコール、ポリビニルアセ タール、ポリビニルブチラール、ポリ酢酸ビニル、ポリ ビニルアルコール、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデ 20 ン、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルエチルエー テル、ポリビニルベンジルエーテル、ポリビニルメチル ケトン、ポリ(Nービニルカルバゾール)、ポリ(Nー ビニルピロリドン)、ポリアクリル酸メチル、ポリアク リル酸エチル、ポリアクリル酸、ポリアクリロニトリ ル、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタクリル酸エチ ル、ポリメタクリル酸プチル、ポリメタクリル酸ベンジ ル、ポリメタクリル酸シクロヘキシル、ポリメタクリル 酸、ポリメタクリル酸アミド、ポリメタクリロニトリ ル、ポリアセトアルデヒド、ポリクロラール、ポリエチ 30 シド、(S) - (-) - N- (5-ニトロ-2-ピリジ レンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリエチレン テレフタレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリカ ーポネイト類(ビスフェノール類+炭酸)、ポリ(ジエ チレングリコール・ピスアリルカーボネイト)類、6-ナイロン、6、6-ナイロン、12-ナイロン、6,1 2-ナイロン、ポリアスパラギン酸エチル、ポリグルタ ミン酸エチル、ポリリジン、ポリプロリン、ポリ(ァー ベンジルーLーグルタメート)、メチルセルロース、エ チルセルロール、ベンジルセルロース、ヒドロキシエチ ルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アセチ 40 ルセルロース、セルローストリアセテート、セルロース トリプチレート、アルキド樹脂(無水フタル酸+グリセ リン)、脂肪酸変性アルキド樹脂(脂肪酸+無水フタル 酸+グリセリン)、不飽和ポリエステル樹脂(無水マレ イン酸+無水フタル酸+プロピレングリコール)、エポ キシ樹脂(ビスフェノール類+エピクロルヒドリン)、 ポリウレタン樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミ ン樹脂、キシレン樹脂、トルエン樹脂、グアナミン樹脂 などの樹脂、ポリ(フェニルメチルシラン)などの有機 ポリシラン、有機ポリゲルマンおよびこれらの共重合・ 50 類、4′-シアノベンジリデン-4-n-プチトキシア

共重縮合体、および、二硫化炭素、四フッ化炭素、エチ ルベンゼン、パーフルオロベンゼン、パーフルオロシク ロヘキサン、トリメチルクロロシランなどの、通常では 重合性のない化合物をプラズマ重合して得た高分子化合 物などを挙げることができる。

【0011】また、これらの有機高分子化合物は有機色 素や光非線形効果を示す有機低分子化合物の残基をモノ マー単位の側鎖として、あるいは架橋基として、共重合 モノマー単位として、または重合開始末端として含有し ていてもよい。しかも、これらの有機高分子化合物は複 数種混合して用いてもよく、「ミクロ相分離」する組合 せにおいて使用してもよい。

[無機微粒子/有機高分子材料] 上記の有機高分子材料 と組み合わせて、この発明の光学薄膜の形成材料として 使用できる無機微粒子の具体例としては、セレン、テル ル、ゲルマニウム、珪素、シリコンカーパイド、Cd-Z n-M n-S e-T e-S-O x ♥G a-I n-A l -As-Pなどの半導体微粒子や金コロイドなどの貴金 **属超微粒子を挙げることができる。** 

「有機低分子/有機高分子材料]上記の有機高分子材料 と組み合わせて、この発明の光学薄膜の形成材料に用い られる有機低分子化合物の具体例としては、尿素および その誘導体、m-ニトロアニリン、2-メチル-4-ニ トローアニリン、2-(N, N-ジメチルアミノ)-5 ーニトロアセトアニリド、N, N'ービス(4-ニトロ フェニル)メタンジアミンなどのペンゼン誘導体、4-メトキシー4′-ニトロピフェニルなどのビフェニル誘 導体、4-メトキシ-4′-ニトロスチルベンなどのス チルベン誘導体、4-二トロー3-ピコリン=N-オキ ル) - プロリノールなどのピリジン誘導体、2<sup>1</sup>,

4′、4′ートリメトキシカルコンなどのカルコン誘導 体、チエニルカルコン誘導体などの2次非線形光学活性 物質の他、各種の有機色素、有機顔料などを挙げること ができる。

【0012】前述のように、これら有機低分子化合物の 残基と有機高分子化合物は化学結合を形成していても良

[液晶] さらにまた、上記の有機高分子材料と組み合わ せて、この発明の光学薄膜の形成材料に用いられる液晶 の具体例としては、種々のコレステロール誘導体、4′ **-n-プトキシベンジリデン-4-シアノアニリン、** 4′-n-ヘキシルペンジリデン-4-シアノアニリン などの4′-アルコキシベンジリデン-4-シアノアニ リン類、4′-エトキシベンジリデン-4-n-プチル アニリン、4′-メトキシベンジリデンアミノアゾベン ゼン、4-(4'-メトキシペンジリデン)アミノビフ ェニル、4-(4'-メトキシベンジリデン)アミノス チルベンなどの4′-アルコキシベンジリデンアニリン

ニリン、4′-シアノベンジリデン-4-n-ヘキシル オキシアニリンなどの4′-シアノベンジリデン-4-アルコキシアニリン類、4′-n-プトキシカルポニル オキシベンジリデン-4-メトキシアニリン、p-カル ボキシフェニル n - アミルカーボネート、n - ヘプチル 4-(4'-エトキシフェノキシカルポニル)フェニル カーボネートなどの炭酸エステル類、4-n-プチル安 息香酸4′-エトキシフェニル、4-n-プチル安息香 酸4′-オクチルオキシフェニル、4-n-ペンチル安 息香酸4′-ヘキシルルオキシフェニルなどの4-アル 10 の含窒素複素環化合物類、トリエチルアミン、トリエタ キルル安息香酸4′-アルコキシフェニルエステル類、 4、4′-ジ-n-アミルオキシアゾキシベンゼン、 4, 4′-ジ-n-ノニルオキシアゾキシベンゼンなど のアゾキシベンゼン誘導体、4-シアノ-4'-n-オ クチルピフェニル、4-シアノ-4'-n-ドデシルピ フェニルなどの4-シアノ-4′-アキルルルピフェニ ル類などの液晶、および(2S, 3S)-3-メチルー 2-クロロペンタノイック酸4′,4″-オクチルオキ シビフェニル、4′-(2-メチルプチル)ピフェニル - 4 - カルポン酸 4 - ヘキシルオキシフェニル、4′- 20 オクチルビフェニルー4-カルボン酸4-(2-メチル ブチル)フェニルなどの強誘電性液晶を挙げることがで きる。

【0013】たとえば以上の通り例示することのできる 有機高分子材料や有機低分子化合物、無機粒子、さらに は液晶物質は、この発明においては適宜な溶媒に溶解す るか、あるいは分散媒に分散させて高真空容器内に噴霧 する。この際の溶媒もしくは分散媒についても各種のも のを使用することができるが、上記のような有機系光学 材料を溶解または分散する溶剤であって、揮発性を有 し、腐食性のないものであれば、任意のものが使用でき

【0014】具体的にはメタノール、エタノール、イソ プロピルアルコール、n-プタノール、アミルアルコー ル、シクロヘキサノール、ベンジルアルコールなどのア ルコール類、エチレングリコール、ジエチレングリコー ル、グリセリンなどの多価アルコール類、酢酸エチル、 酢酸n-ブチル、酢酸アミル、酢酸イソプロピルなどの エステル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ エチルエーテル、ジブチルエーテル、メトキシエタノー ル、エトキシエタノール、プトキシエタノール、カルビ トールなどのエーテル類、テトラヒドロフラン、1,4 - ジオキサンなどの環状エーテル類、ジクロロメタン、 クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、 1, 1, 2-トリクロロエタン、トリクレンなどのハロ ゲン化炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、ク ロロベンゼン、o-ジクロロベンゼン、ニトロベンゼ ン、アニソール、αークロロナフタレンなどの芳香族炭 化水素類、n-ペンタン、n-ヘキサン、n-ヘプタ

ン、シクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素類、N、N-ジメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミ ド、ヘキサメチルホスホリックトリアミドなどのアミド 類、N-メチルピロリドンなどの環状アミド類、テトラ メチル尿素、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン などの尿素誘導体類、ジメチルスルホキシドなどのスル ホキシド類、炭酸エチレン、炭酸プロピレンなどの炭酸 エステル類、アセトニトリル、プロピオニトリル、ベン ゾニトリルなどのニトリル類、ピリジン、キノリンなど ノールアミン、ジエチルアミノアルコール、アニリンな どのアミン類、などの他、水、ニトロメタン、二硫化炭 素、スルホランなどの溶剤を用いることができる。

【0015】これらの溶剤は、また、複数の種類のもの を混合して用いてもよい。これらの溶媒もしくは分散媒 に溶解または分散させた状態で有機系光学材料を高真空 容器内に噴霧して薄膜形成することをこの発明は特徴と しているが、この方法の実施に際しては、たとえば以下 の通りの装置とその操作法の採用によって薄膜形成を可 能とすることができる。

【0016】すなわち、まず、この発明の光学薄膜の製 造装置の構成は、図1に例示することができ、有機系光 学材料の溶液または分散液をたとえば圧力1×10<sup>-1</sup>P a以下の真空中へ噴霧するための制御ノズル部(1) お よび制御ノズル部の開閉機構部(2)を真空容器(3) 内に有し、さらにこの真空容器(3)内で揮発した溶媒 等の蒸気を迅速に排気し、圧力を1×10<sup>-4</sup>Pa以下に 保つ真空ポンプ(4)を備えている。また、この装置に は、前記真空容器(3)内に設置した圧力測定装置 (5)、真空容器(3)内で揮発した溶媒等の蒸気が真 空ポンプ(4)へ到ることを防止するためのコールドト ラップ(6)、ノズル部(1)と基板の間を遮蔽するシ ャッター(7)、基板加熱装置(8)、および基板温度 測定装置(9)をも備え、真空容器(3)内の基板(1 9) 表面に有機系光学薄膜を形成することができるよう にしている。

【0017】この装置には、必要に応じて、真空容器 (3) のペーキング装置(10)、ゲート弁(11)、 イオン化装置(12)、質量分析装置(13)、基板導 ソプチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類、ジ 40 入装置(14)、マニュピュレーター(15)およこれ らの制御装置を設けることが好ましい。真空ポンプは、 真空容器(4)を大気圧から高真空、より好ましくは、 1×10 Pa以下の圧力へできる限り迅速に排気し、 かつ真空容器内で揮発し、コールドトラップに捕獲され きれなかった溶媒等の気体成分を迅速に排気し、真空容 器内の圧力を1×10'Pa以下に保つことができるも のであれば、任意のものが使用可能である。具体的には ターボ分子ポンプとロータリーポンプの組合せや、油拡 散ポンプとロータリーポンプの組合せを使用することが 50 できる。

8

【0018】また、図1に例示したように真空容器

7

(3) に備えたイオン化装置(12)および質量分析装置(13)、および基板導入装置(14)部には別系統の真空ポンプ(16)(17)を設けることが好ましい。なお、圧力測定装置(5)については、一般的には $1\times10^{-1}$  Pa以下の圧力を正確に測定できるものであれば公知の任意のものを使用することができる。たとえば具体的には、Bayard-Alpert型などの電離真空計を使用できる。

【0019】真空容器(3)については、装置構成部品 10 を、真空計の容積が最小になるように配置する形態のものが好ましい。材質は高真空仕様のアルミニウムまたはステンレスが好ましい。基板加熱装置(8)はヒーター部分を真空系内に置く形式と、真空系外から加熱する方式のいずれでも良く、基板(19)の形態に応じて、任意のものが使用可能である。

【0020】なお、この基板加熱装置(8)は基板温度を所定の値に制御する機構を含むものとする。基板温度測定装置(9)は基板(19)の温度を測定するものであり、熱電対など測温部を高真空下に置いても作動する20ものであれば任意のものが使用できる。

【0021】ベーキング装置(10)は真空系を構成する部品全てを加熱処理できるものが好ましい。コールドトラップ(6)は高真空容器内で揮発した溶媒等の蒸気を確実に捕捉し、かつ排気の妨げにならないものであれば、任意の方式のものが使用できる。イオン化装置(12)および質量分析装置(13)は必ずしも必要ではないが、基板(19)上の堆積物から発生する揮発成分が完全に除去されたことを確認する上で有用である。

【0022】ゲート弁(11)はイオン化装置(12) および質量分析装置(13)と真空容器(3)の間を適時遮蔽するものであり、必ずしも設ける必要はないが、真空系内に噴霧された成分および溶剤などが飛来して質量分析装置(13)を汚染することを防ぐ上で有用である。ゲート弁(11)を設ける場合は真空容器(3)および質量分析装置(13)部分に別系統の真空排気系(16)を接続することが好ましい。

【0023】イオン化装置(12)は該真空系内に存在する揮発成分をイオン化する形式のものであれば公知の各種のものが使用可能である。具体的にはガス放電式、アーク放電式、電子衝撃式などのイオン化装置を使用することができる。質量分析装置(13)はイオン化装置(12)で発生させたイオンの質量mをそのイオンの電荷eで除した数m/eに応じて質量を分離する部分(質量分離系)と、m/eに応じて分離されたイオンの数を電気的に計数する部分(検出・記録系)からなるものであれば、公知の各種のものが使用できる。

【0024】質量分離系は磁界および/あるいは電界を 加熱装置(20)によって堆利制御してm/eに応じてイオンを分離するものであり、 の表面加熱装置(20)としてパラボラ型、速度収束型、方向収束型、二重収束型、お 50 の他適宜な手段が採用できる。

よび飛行時間型などの形式のいずれでもよい。検出・記録系としてはファラデー箱と高感度直流増幅器の組合せ、二次電子増倍装置と高感度直流増幅器の組合せなどの方式のものを使用することができる。

【0025】基板導入装置(14)は、必ずしも設ける必要はないが、高真空容器(13)内へ基板(19)を設置する際の排気時間を短縮する上で有効である。基板導入装置(14)は真空容器、外部から試料を導入するための蓋またはゲート弁、磁気カップリング式またはベローズ式の直線導入機、測定装置の真空容器との間のゲート弁、真空ポンプ、および圧力測定装置から構成することができる。

【0026】マニュピュレーター(15)は、必ずしも設ける必要はないが、ノズル部(1)に対する基板(19)の位置や向きを微調整する際に有用である。材料の溶液、分散液、または溶融液を真空容器内へ噴霧するための制御ノズル部(1)はこの発明の光学薄膜の製造装置の中で、特に重要な部分である。そして、制御ノズル部から噴霧させる液体が制御ノズル部分で固化してノズルを閉塞させることを避け、噴霧量を制御することもできるノズル開閉機構を備える必要がある。

【0027】閉塞を解消する機構としては、真空系外から操作するワイパーを使用することができるが、操作性および効果の点で難点がある。この発明の発明者は制御ノズルの一例として、図2に断面図を例示したように、高加工精度のニードルバルブを利用することができることを見出した。すなわち、制御ノズル部(1)には、ニードルバルブ(100)を設け、ノズル部の開閉機構部(2)によってこのニードルバルブ(100)を動かし、制御ノズル部(1)からの有機系光学材料液の噴霧量を調整し、その閉塞を防止する。

【0028】有機系光学材料の液は、液体溜め(18)より制御ノズル部(1)に供給する。たとえば以上の装置においては、前記の制御ノズル部(1)より有機系光学材料を溶液または分散液の状態で高真空容器(3)内において噴霧し、溶媒または分散媒体を真空蒸発させながら、基板(19)上に有機系光学材料による薄膜を堆積させる。

【0029】そして、この発明においては、この基板 (19)を堆積物の熱分解温度を越えない温度まで加熱して揮発成分を除去し、さらに必要に応じて基板上の堆積物を加熱および/あるいは加圧して所要のものに成形する。もちろん基板 (19)の種類に特に限定はなく、ガラス、石英をはじめ、セラミックス、Si、ポリマー等の任意のものであってよい。そしてこの基板 (19)上の堆積物の加熱処理は、基板 (19)の加熱として行うこともできるし、あるいは、図1に示した基板の表面加熱装置 (20)によって堆積物を加熱してもよい。この表面加熱装置 (20)としては、電熱ヒーターや、その地流気なまいが採用できる。

【0030】また、さらに成形のための加圧について は、熱間圧延処理(たとえば特開平4-99609号) として公知の手段を採用してもよい。いずれにしてもこ の発明の製造方法とそのための装置によって、より低温 度で、光学材料を熱分解させることなく、高品質で、高 機能な有機系光学薄膜の形成が容易となる。そして、こ の発明によって、1種または2種類以上の有機系高分子 化合物や低分子化合物およびそれらと無機化合物の混合 状態でマイクロメートル未満の微細領域で制御された有 機系光学薄膜の形成が可能となる。

【0031】また、特に、数百MW/cm<sup>1</sup> ないし数百 GW/cm<sup>i</sup> の高パワー密度レーザー光に耐える有機系 光学薄膜の作成も可能となる。以下実施例を示し、さら に詳しくこの発明の方法について説明する。

#### [0032]

【実施例】図1および図2にその構成を例示した装置を 用いて光学薄膜を製造した。すなわち、真空容器(3) 内を真空排気装置(4)、たとえばターポ分子ポンプ及 び油回転ポンプにより真空排気後、容器(3)内の圧力 下の圧力であることを確認する。

【0033】有機系光学材料としての3,3´-Diethy loxadicarbocyanine lodide (DODCI) を適当な溶 媒、たとえば、アセトンに10゚゚モル/リットルの濃度 で溶解し、液溜め(18)に充填した後、制御ノズル部 (1) より毎分100マイクロリットルの割合で、真空 容器(3)内に噴霧する。この時、有機系光学薄膜の堆 積を行う基板(19)は、基板加熱装置(8)および基 板温度測定装置(9)により、たとえば40℃に加熱す

【0034】膜厚制御は噴霧時間により行うこととし、 たとえば10分間の噴霧により0.5ミクロンのDOD CI膜を形成する。基板 (19) 表面より除去された溶 媒等の揮発成分は、真空容器(3)内に設置されたコー ルドトラップ(6)に捕獲され、真空ポンプ(4)へ到 ることを防止する。

【0035】また、たとえば1ミクロン以上の膜厚を有 する薄膜を堆積する際には、赤外線等による表面加熱装 置(20)によって基板加熱を行い、基板表面に到達し た揮発成分の除去を速やかに行う。堆積されたDODC I 薄膜のDODCIの粒子径を、たとえばX線小角散乱 10 法により測定すると、約50ナノメートルであった。

【0036】一方、前記のDODCIをポリマー中、た とえばポリメチルメタクリレート(PMMA)中に分散 させる場合には、DODCI及びPMMAの双方を溶解 する適当な溶媒、たとえばアセトンにDODC I を 1 0 ットルの濃度でそれぞれ溶解して溶解溜め(18)に充 填した後、制御ノズル部(1)より毎分100マイクロ リットルの割合で、真空容器(3)内に噴霧する。

【0037】この時の基板温度等の条件は上記と同様に を圧力測定装置(5)により測定し、1×10<sup>-</sup>′Pa以 20 設定する。堆積されたDODCIを含有するPMMA薄 膜(DODCI/PMMA)は、ホットプレス法により 真空中にて加熱・加圧処理し、光学的に透明な薄膜を得 た。この場合、たとえば、150℃の温度で、50kg /cm'の静水圧プレスにより、10分間保持する。

> 【0038】このDODCI/PMMA薄膜内のDOD CIの粒子径を、たとえばX線小角散乱法により測定す ると、約30ナノメートルであった。表1は、以上得ら れた薄膜のX線小角散乱法によって測定された結晶粒径 とその割合(重合比)の測定結果を示したものである。

30 微細構造組織が実現されていることがわかる。

[0039]

【表1】

| 715 DE | 結 晶 粒 径  | 重量比 |
|--------|----------|-----|
| 薄膜     | (ナノメートル) | (%) |
| DODCI膜 | 50.3     | 8 0 |
|        | 105.4    | 2 0 |
| DODC1/ | 29.7     | 7 7 |
| PMMA膜  | 82.5     | 2 3 |

#### [0040]

【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この発明によ って、有機系光材料の分解・変性温度よりもはるかに低 い温度において薄膜形成が可能となる。そして、この発 明の光学薄膜の方法に使用される有機系光学材料は、加 熱および/あるいは加圧により成形することが可能なも のであれば、最適な溶媒の選択により任意のものを使用 50 1 制御ノズル部

することができ、この発明は、有機系光学材料を開発、 改良する上で極めて有用なものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の装置構成を例示した構成図である。

【図2】制御ノズル部を例示した構成断面図である。

【符号の説明】

11

2 開閉機構部

3 真空容器

4 真空ポンプ

5 圧力測定装置

6 コールドトラップ

7 シャッター

8 基板加熱装置

9 基板温度測定装置

10 ベーキング装置

11 ゲート弁

12 イオン化装置

13 質量分析装置

14 基板導入装置

15 マニュピュレーター

16 真空ポンプ

17 真空ポンプ

18 液溜め

19 基板

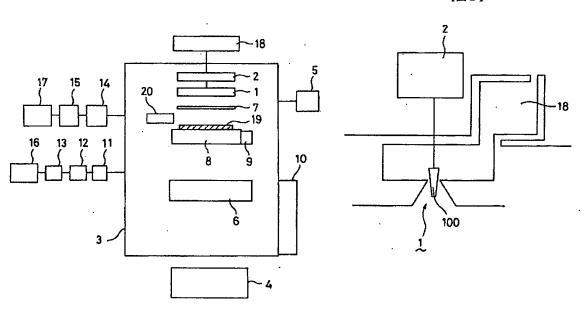
20 表面加熱装置

10 100 ニードルバルブ

【図1】

【図2】

12



#### 【手続補正書】

【提出日】平成6年6月13日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

### 【補正内容】

【0003】このような新しい高機能光学薄膜を形成するための素材、その組成として注目されているものに有機系光学材料がある。この有機系光学材料を用いた有機系光学薄膜の製造方法についても各種の検討がこれまでにも進められており、たとえば以下のような方法が知られてもいる。

(1) 溶液、分散液、または、展開液を用いる湿式法 塗布法、ブレードコート法、ロールコート法、スピンコート法、ディッピング法、スプレー法などの塗工法、平版、凸版、凹版、孔版、スクリーン、転写などの印刷 法、電着法、電解重合法、ミセル電解法(特開昭63243298) などの電気化学的手法、水の上に形成させた単分子膜を移し取るラングミア・プロジェット法など。

(2) 原料モノマーの重合ないし重縮合反応を利用する 方法

モノマーが液体の場合、キャスティング法、リアクション・インジェクション・モールド法、プラズマ重合法、 光重合法など。

(3) 気体分子を用いる方法(加熱による気化法) 昇華転写法、蒸着法、真空蒸着法、イオンビーム法、ス パッタリング法、プラズマ重合法、光重合法など。

(4)溶融あるいは軟化を利用する方法 ホットプレス法(特開平4-99609)、射出成形 法、延伸法、溶融薄膜の単結晶化方法など。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

# 【補正方法】変更

#### 【補正内容】

【0019】真空容器(3)については、装置構成部品を、真空系の容積が最小になるように配置する形態のものが好ましい。材質は高真空仕様のアルミニウムまたはステンレスが好ましい。基板加熱装置(8)はヒーター部分を真空系内に置く形式と、真空系外から加熱する方式のいずれでも良く、基板(19)の形態に応じて、任意のものが使用可能である。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 5 【補正方法】変更 【補正内容】

【0025】基板導入装置(14)は、必ずしも設ける必要はないが、高真空容器(3)内へ基板(19)を設置する際の排気時間を短縮する上で有効である。基板導入装置(14)は真空容器、外部から試料を導入するための蓋またはゲート弁、磁気カップリング式またはベローズ式の直線導入機、測定装置の真空容器との間のゲート弁、真空ポンプ、および圧力測定装置から構成することができる。

#### フロントページの続き

# (72)発明者 平賀 隆

茨城県つくば市春日1-101-308

(72)発明者 守谷 哲郎

茨城県つくば市梅園1-1-4 通商産業 省工業技術院 電子技術総合研究所内

(72)発明者 田中 教雄

東京都足立区堀之内1丁目9番4号 大日 精化工業株式会社東京製造事業所内 THIS PAGE BLANK (USPTO)